

■ Prawo Gaussa

→ Strumień pola elektrycznego  $\vec{E}$

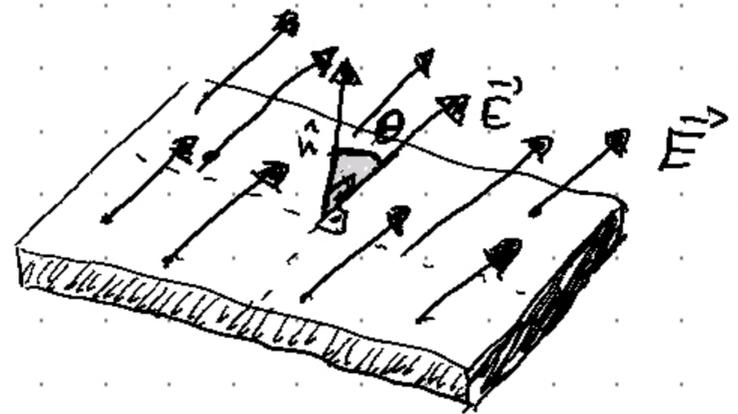
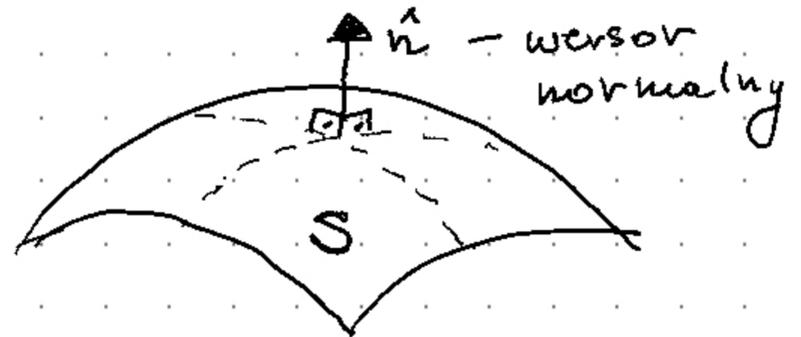
Definiujemy wektor  $\vec{S} = S \hat{n}$ , którego wartość jest polem powierzchni, a wektor  $\hat{n}$  jest prostopadły do powierzchni i skierowany na zewnątrz tej powierzchni.

Strumień pola elektrycznego  $\vec{E}$  przez powierzchnię definiujemy jako

$$\Phi_E = \vec{E} \cdot \vec{S} = ES \cos \theta$$

gdy  $\vec{S} \perp \vec{E} \Rightarrow \Phi_E = 0$ ,

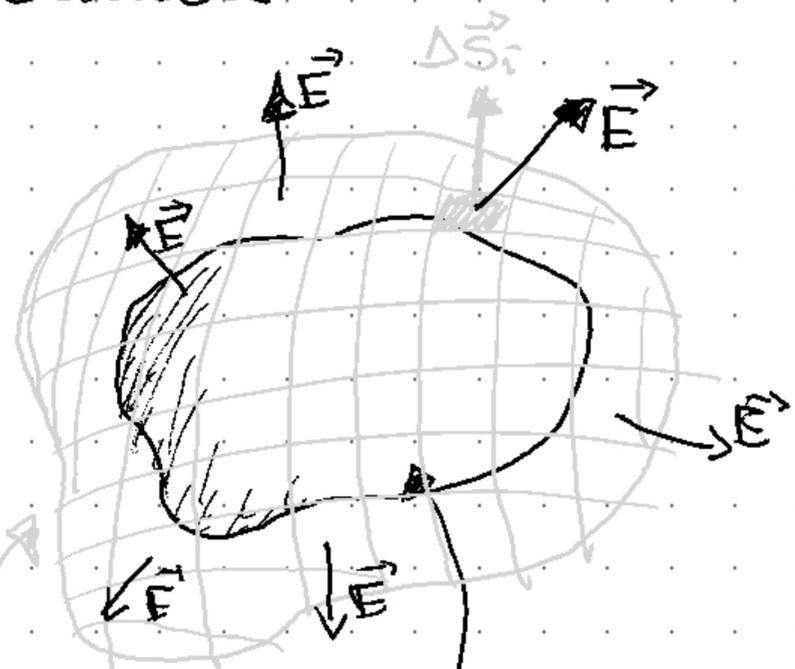
$\vec{S} \parallel \vec{E} \Rightarrow \Phi_E = ES$ .



→ Sformułowanie prawa Gaussa

$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

↑ strumień pola elektrycznego przez zamkniętą powierzchnię - powierzchnia Gaussa



$$\Phi_E = \frac{Q_{wew.}}{\epsilon_0}$$

ładunek zamknięty wewnątrz powierzchni Gaussa

zamknięta powierzchnia (pow. Gaussa) natadowane elektrycznie ciało

Jeżeli nasz problem ma wysoką symetrię, wtedy można łatwo wykonać całki występujące w równaniu na  $\Phi_E$ .

Symetria	Układ	Powierzchnia Gaussa, która wygodnie wybrać
Sferyczna	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kula wykonana z izolatora</li> <li>• Powłoka sferyczna wykonana z przewodnika</li> <li>• ładunek punktowy</li> </ul>	Koncentryczna sfera
Osiowa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• walec wykonany z izolatora,</li> <li>• powłoka walcowa wykonana z przewodnika</li> <li>• nieskończona linia</li> </ul>	współosiowy cylinder
Płaska	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nieskończona płyta</li> <li>• płyta o pewnej grubości wykonana z izolatora</li> </ul>	Pudełko o denkach równoległych do płyty.

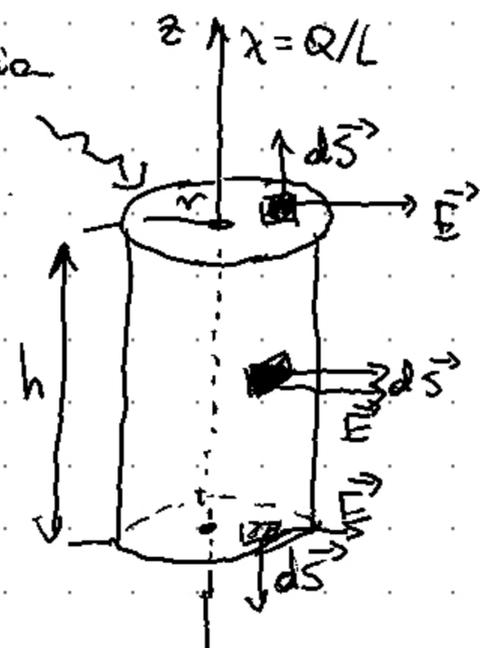
Przykłady:

1°) Nieskończony drut

liniowa gęstość ładunku:  $\lambda = Q/L$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_{\text{denko górne}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{\text{denko dolne}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{\text{powierzchnia boczna}} \vec{E} \cdot d\vec{S} =$$

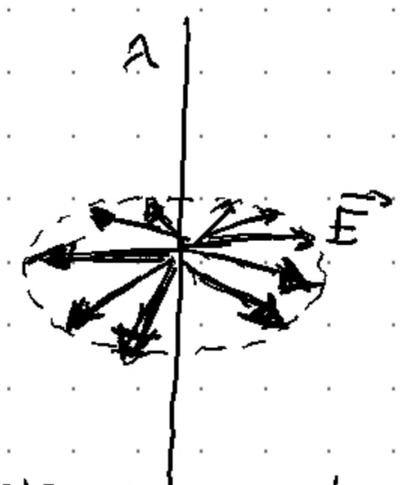
powierzchnia Gaussa



$$= E \int dS \approx E(2\pi hr) = \frac{1}{\epsilon_0} (\underbrace{\lambda \cdot h}_{Q_{\text{weo}}}) \Rightarrow E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 L r}$$

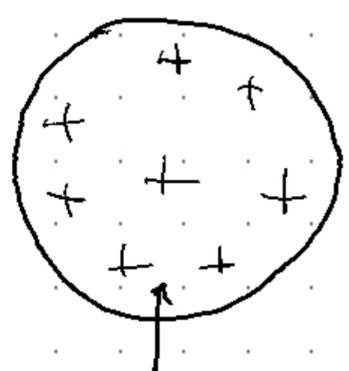
powierzchnia boczna

problem jest osiowoosymetryczny, więc E zależy tylko od odległości w płaszczyźnie xy od druta. Dla taki wybranego konturu E = const na jego powierzchni

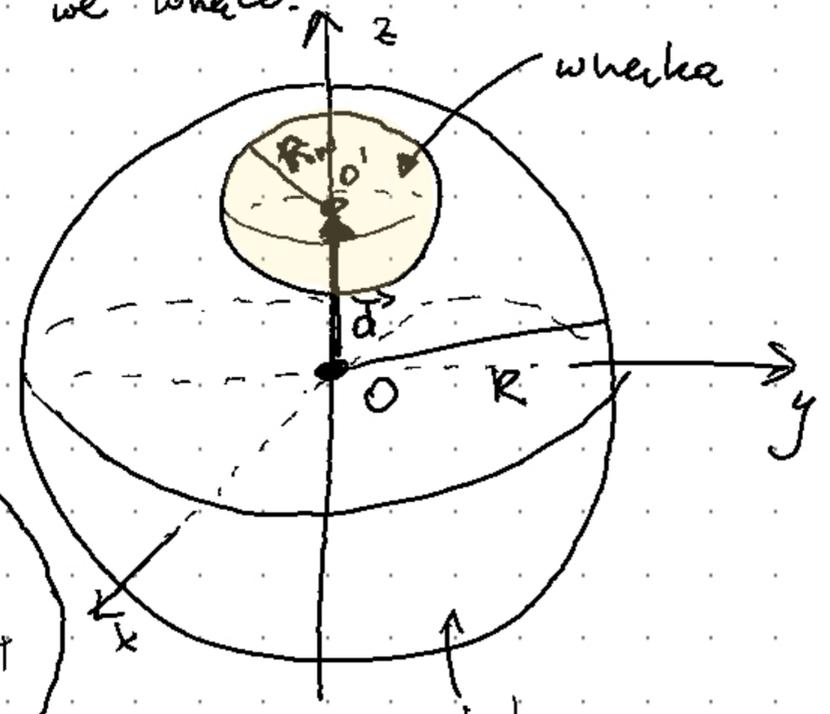
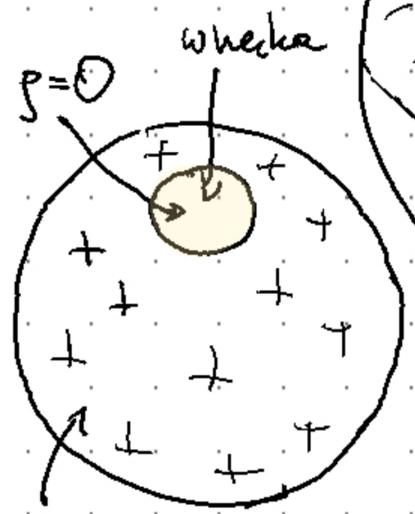


2°) Naladowana kula wykonana z izolatora z wneka wewnatrz. Jeli jest pole we wnece?

W zadaniu tym zastosujemy zasada superpozycji dla pol E:



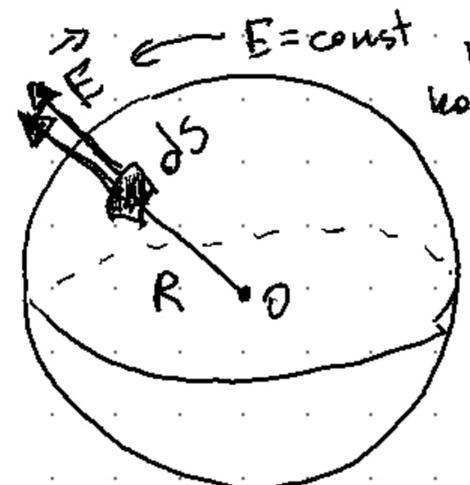
$$\rho = \frac{Q}{\frac{4}{3}\pi R^3}$$



jednorodnie ladunkiemi o gestosci obietosionej

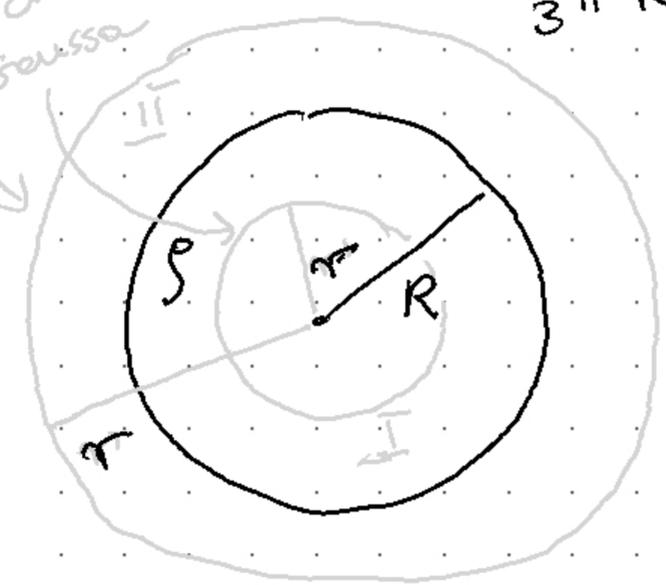
$$\rho = \frac{Q}{\frac{4}{3}\pi R^3}$$

Liczmy pole elektryczne pochodzace od kuli:



E = const na koncentrycznej powierzchni sferycznej

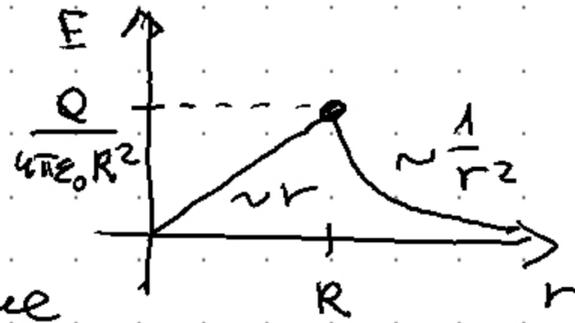
powierzchnia Gaussa



$$\oint_{\text{kula}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \oint_{\text{kula}} dS = 4\pi r^2 E = \begin{cases} \frac{1}{\epsilon_0} \rho \cdot \frac{4}{3}\pi r^3, & r < R \\ \frac{1}{\epsilon_0} \rho \cdot \frac{4}{3}\pi R^3, & r \geq R \end{cases}$$

$\vec{E} \parallel d\vec{S}$   
 $Q_{\text{wew.}}$

$$\Rightarrow E = \begin{cases} \frac{\rho}{3\epsilon_0} r, & r < R \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}, & r \geq R \end{cases}$$

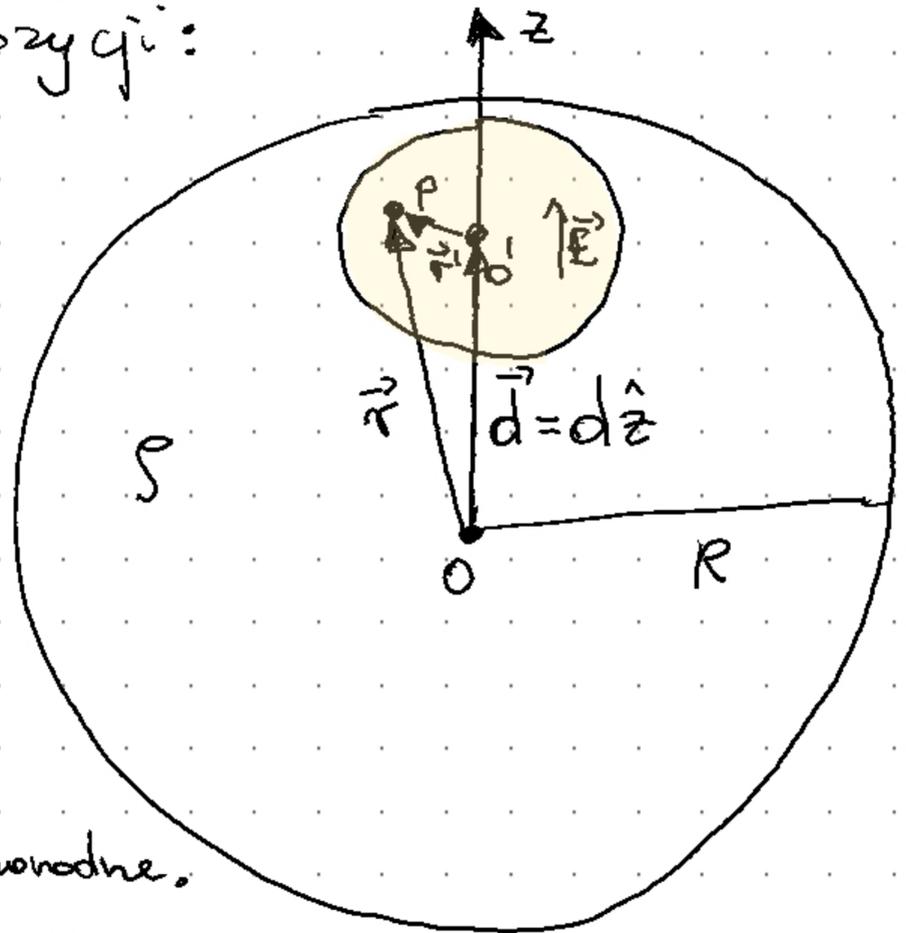


Pole elektryczne jest skierowane radialnie, czyli

$$\vec{E} = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \vec{r}, \quad r < R, \quad (\vec{r} = x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z})$$

Stosujemy zasadę superpozycji:

$$\begin{aligned} \vec{E} &= \frac{\rho}{3\epsilon_0} \vec{r} - \frac{\rho}{3\epsilon_0} \vec{r}' = \\ &= \frac{\rho}{3\epsilon_0} \vec{r} - \frac{\rho}{3\epsilon_0} (\vec{r} - \vec{d}) = \\ &= \frac{\rho}{3\epsilon_0} \vec{d} = \frac{\rho d}{3\epsilon_0} \hat{z} \end{aligned}$$



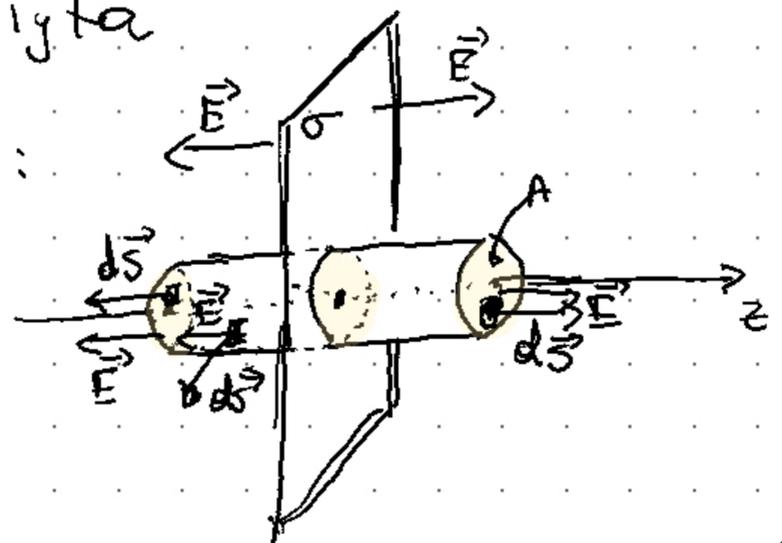
Pole wewnątrz wneki jest jednorodne.

3°) Jednorodnie naładowana płyta

Powierzchniowa gęstość ładunku:

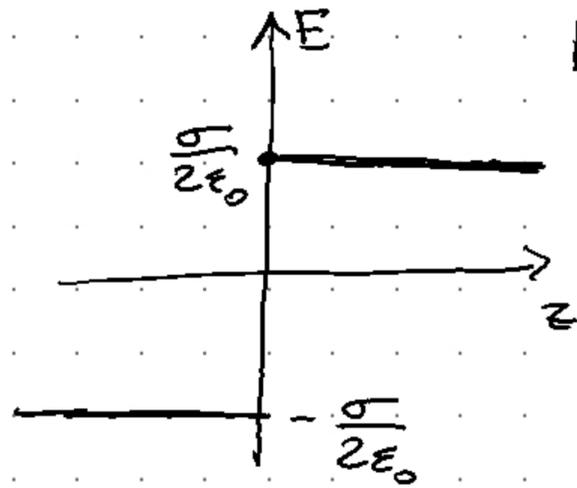
$$\sigma = Q/S$$

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_{\text{denka}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{\text{boczna}} \vec{E} \cdot d\vec{S} =$$



$$= 2 \int_{\text{denko}} E dS \equiv 2 E \int dS = 2EA = \frac{\sigma A}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

z symetrii wynika, że na denku  $\vec{E}$  jest stałe



$$\vec{E} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \hat{z}$$

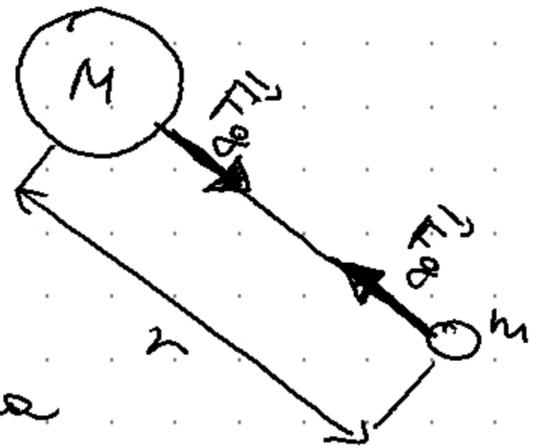
Wartość pola  $\vec{E}$  doznaje skoku na płycie.

## ■ Prawo Gaussa dla grawitacji

Prawo powszechnego ciążenia:

$$\vec{F}_g = - \frac{GMm}{r^2} \hat{r}$$

gravitacja jest zawsze przyciągająca



$$\vec{\gamma} = \frac{\vec{F}_g}{m} \leftarrow \text{masa próbna}$$

↑ natężenie pola grawitacyjnego

Prawo Gaussa dla grawitacji:

$$\Phi_G = \oint_S \vec{\gamma} \cdot d\vec{S} = -4\pi G M_{\text{wew.}}$$

Strumień  $\vec{\gamma}$  pola grawitacyjnego przez powierzchnię zamkniętą

↑ masa ograniczonej powierzchni Gaussa

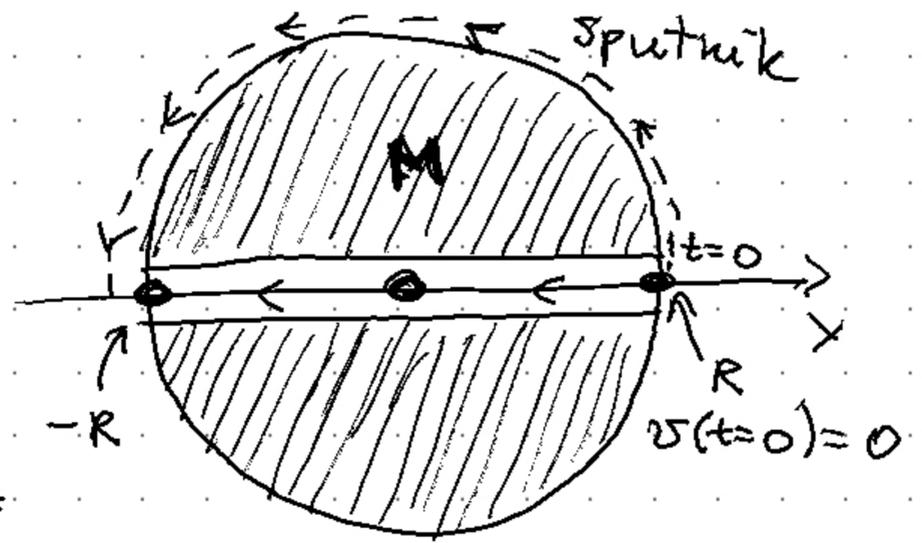
### Przykład:

Opisać ruch ciała w tunelu przechodzącym przez środek Ziemi i porównać go z ruchem satelity krążącego nad powierzchnią Ziemi ( $h \ll R$ ) po orbicie kołowej. Założyć, że Ziemia jest jednorodna.

Stosujemy prawo Gaussa:

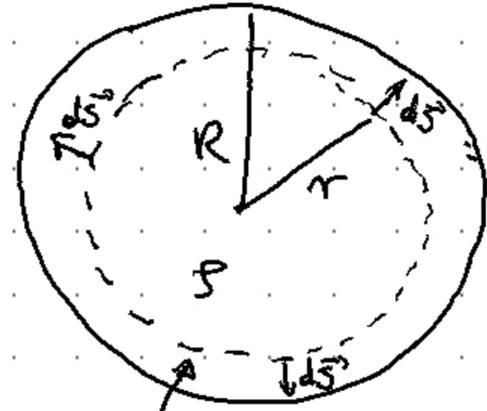
$$\rho = \frac{M}{\frac{4}{3}\pi R^3}$$

↑ gęstość



$$\oint_S \vec{\gamma} \cdot d\vec{S} = \gamma \oint_{\text{sfera}} dS = \gamma 4\pi r^2 =$$

$$\left. \begin{array}{l} \vec{\gamma} \parallel d\vec{S} \\ \gamma = \text{const.} \\ \text{dla danego } r \end{array} \right\} \begin{array}{l} = -4\pi G M_{\text{wew}} = \\ = -4\pi G \rho \frac{4}{3}\pi r^3 \end{array}$$



$$\Rightarrow \gamma = -\frac{4\pi}{3} G \rho r$$

W naszym przypadku  $r$  leży wzdłuż  $\vec{x}$ :

$$\vec{\gamma} = -\frac{4\pi}{3} G \rho \vec{x} = -\frac{GM}{R^3} \vec{x}$$

$$= \left( \frac{M}{\frac{4}{3}\pi R^3} \right)$$

Siła wypadkowa:  $\vec{F}_{\text{wyp}} = -\frac{GMm}{R^3} \vec{x}$

$$\Rightarrow \ddot{x} + \frac{GM}{R^3} x = 0 \quad \text{równanie oscylatora harmonicznego}$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{GM}{R^3}}, \quad \omega \text{ więcej}$$

$$x(t) = A \cos(\omega_0 t + \delta)$$

↑ mch drgający

Warunki początkowe:

$$x(0) = R = A \cos \delta$$

$$v(t=0) = \left. \frac{dx}{dt} \right|_{t=0} = -A\omega_0 \sin(\omega_0 \cdot 0 + \delta) = -A\omega_0 \sin \delta = 0$$

$$\Rightarrow \delta = 0$$

cykli  $A = R$ , więc  $x(t) = R \cos\left(\sqrt{\frac{GM}{R^3}} t\right)$

Zobowiązując brak innych sił okres ruchu wynosi:

$$T = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi \sqrt{\frac{R^3}{GM}}$$

Czas lotu z  $x = R$  do  $x = -R$  wynosi

$$t_c = \frac{1}{2} T = \pi \sqrt{\frac{R^3}{GM}}$$

Ruch satelity po orbicie kołowej o promieniu  $R$  możemy opisać równaniem:

$$F_{\text{dośr}} = \frac{mv^2}{R} = G \frac{mM}{R^2} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{GM}{R}} = \text{const}$$

Czas lotu od  $x = R$  do  $x = -R$  wynosi

$$t_s = \frac{\pi R}{v} = \pi \sqrt{\frac{R^3}{GM}} = t_c$$

Rzut mchu po okręgu na wybranej oś jest ruchem harmonicznym, stąd mamy  $t_c = t_s$ .

### ■ Własności przewodników

1°) ładunki wewnątrz przewodników mogą poruszać się w swobodny sposób.

2°) Pole elektryczne  $\vec{E} = 0$  wewnątrz przewodnika.

- Pod wpływem zewnętrznego pola  $\vec{E}_{\text{zew.}}$  elektryki tak długo przemieszczają się aż wytworzą rozkład ładunków znosi wewnątrz zewnętrzne pole elektryczne.

3°) Nadmiarowe ładunki gromadzą się na powierzchni przewodnika.

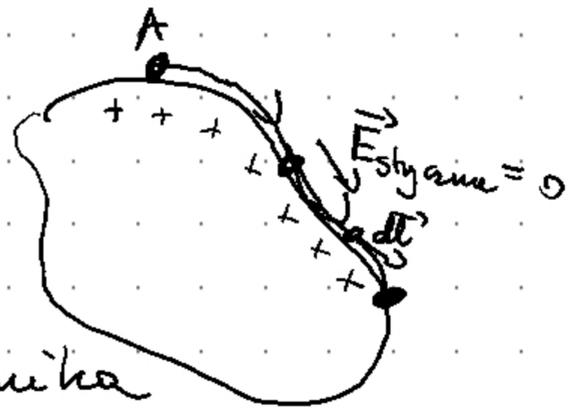
- Wynika to z prawa Gaussa, ponieważ  $\vec{E} = 0$  wewnątrz, więc ładunek jest wewnątrz równy zero.

4°) Składowe styczne pola elektrycznego  $\vec{E}_{styczne}$  do powierzchni przewodnika jest równa zero na jego powierzchni.

$$\vec{E}_{styczne} \Big|_{\text{na powierzchni przewodnika}} = 0$$

Napięcie jest dane relacją:  $U = \left| \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} \right|$

$$U = \left| \int_A^B \vec{E}_{styczne} \cdot d\vec{l} \right| = 0 \Rightarrow \varphi(A) = \varphi(B)$$



Implikuje to, że powierzchnia przewodnika jest powierzchnią ekwipotencjalną.

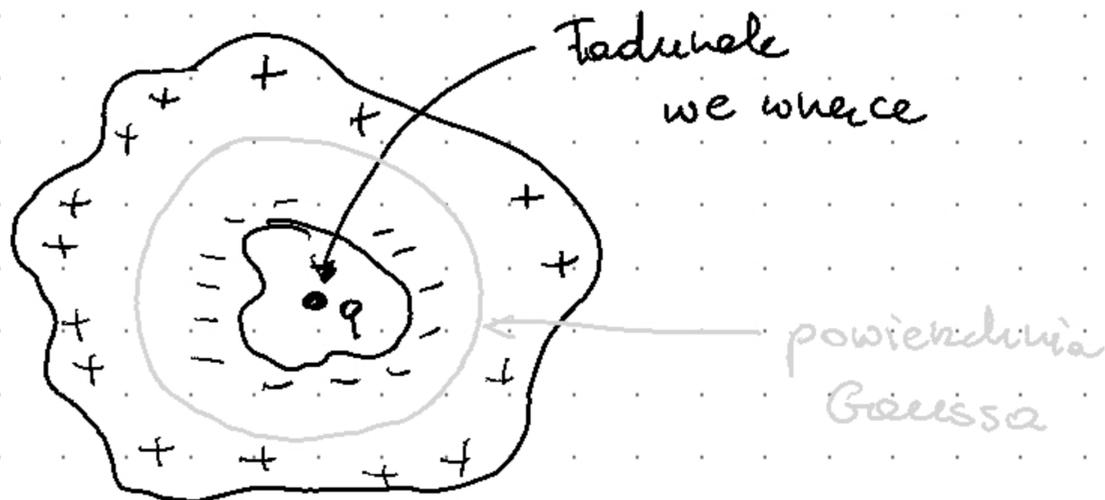
5°) Składowa normalna pola elektrycznego  $\vec{E}_{normalna}$  przy powierzchni przewodnika jest związana z ładunkiem powierzchniowym na przewodniku:

$$\begin{aligned} \Phi_E &= \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = E_{normalna} A + 0 \cdot A = \\ &= \frac{\sigma A}{\epsilon_0} \\ \Rightarrow E_{normalna} &= \frac{\sigma}{\epsilon_0} \end{aligned}$$



## Przykłady:

- 1°) ładunek punktowy we wnętrzu przewodnika



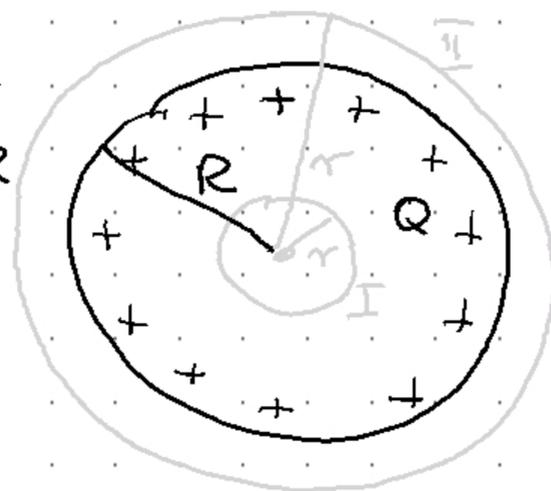
Wolność wewnętrznej gromadzi się ładunek w taki sposób by zniwelować wpływ ładunku we wnętrzu.

Taki proces nazywa się ekranowaniem. Wolność wewnętrznej gromadzi się ładunek  $-q$ .

- 2°) Potencjał wewnątrz przewodnika sferycznego

$$\Phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = 4\pi r^2 E = \begin{cases} 0, & r < R \\ Q/\epsilon_0, & r \geq R \end{cases}$$

$$\Rightarrow \vec{E} = \begin{cases} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}, & r \geq R \\ 0, & r < R \end{cases}$$

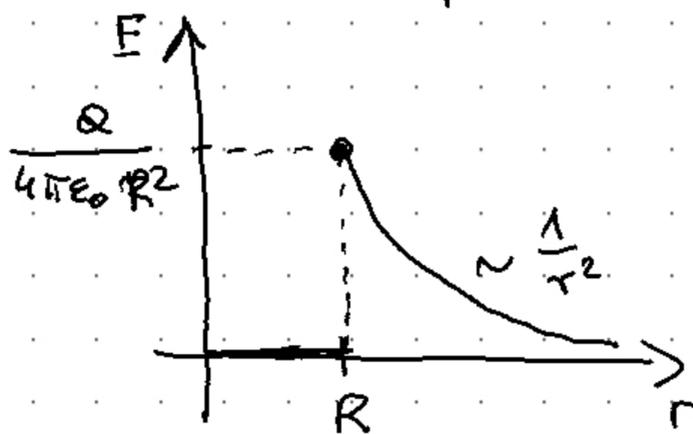


Potencjał dla  $r \geq R$ :

$$\varphi(r) - \varphi(\infty) = - \int_{\infty}^r \vec{E} \cdot d\vec{r} =$$

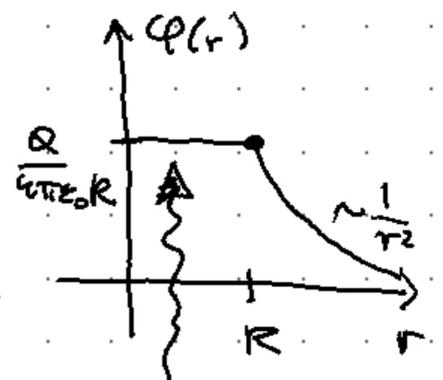
$$= - \int_{\infty}^r \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r'^2} dr' =$$

$$= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} \quad \text{dla } r \geq R$$



Potencjał dla  $r < R$ :

$$\begin{aligned} \varphi(r) - \varphi(\infty) &= - \int_{\infty}^R E(r \geq R) dr - \int_R^r E(r < R) dr = \\ &= - \int_{\infty}^R \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R} \quad \text{dla } r < R \end{aligned}$$

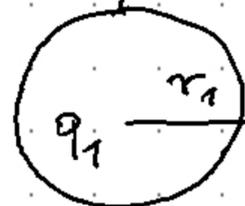


3°) Rozkład ładunku na ostro



modelujemy ostro dwoma kulami

$Q_1, Q_2$



drut z przewodnika

wewnątrz przewodnika potencjał jest stały.

Potencjał wewnątrz przewodnika jest stały, czyli

$$\varphi = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 r_1} = \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 r_2} \Rightarrow \frac{Q_1}{r_1} = \frac{Q_2}{r_2}$$

Oznacza to, że ładunki gromadzą się na ostro, tj. im mniejszy promień krzywizny tym większy ładunek tam się gromadzi.

Co więcej wiemy, że składowe normalne na obu kulach wynoszą:

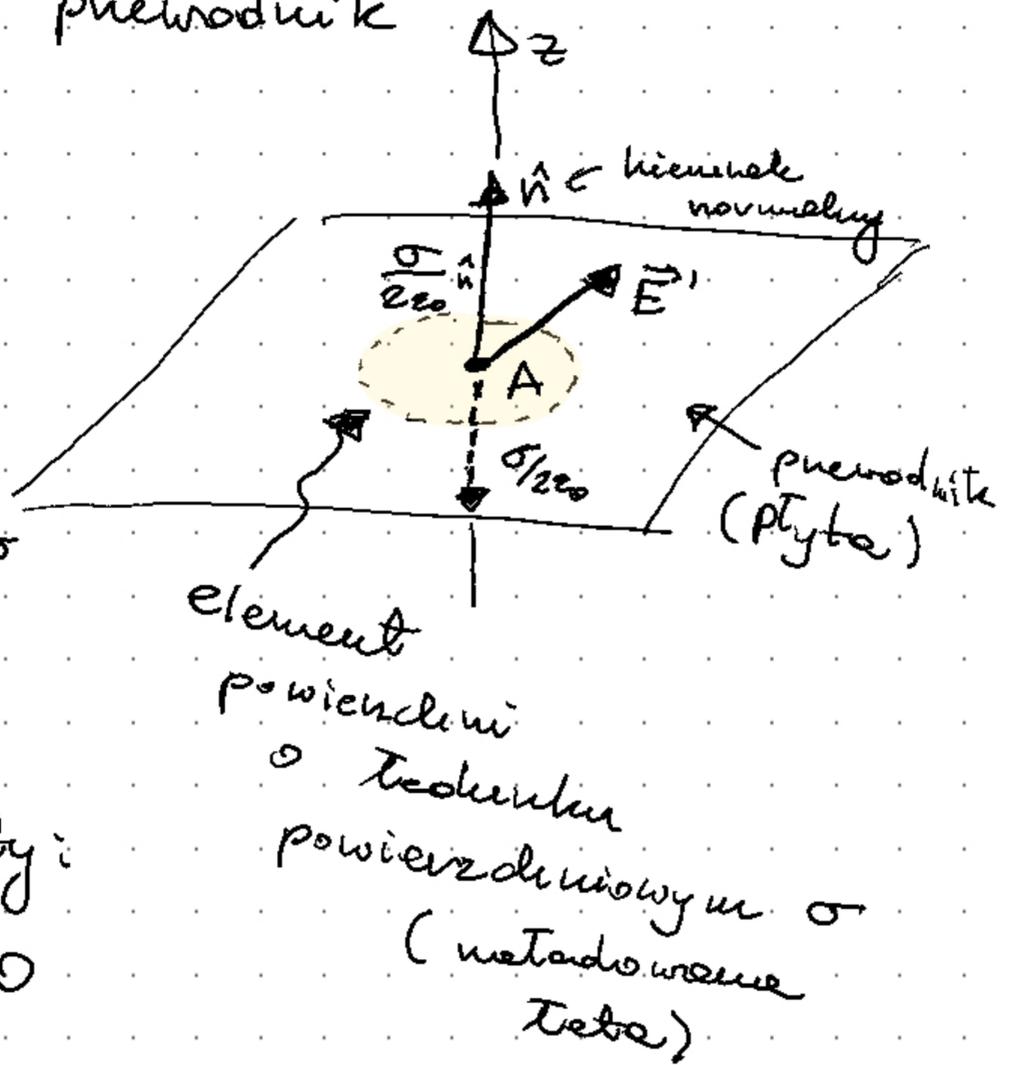
$$E_1 = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 r_1^2} = \frac{\sigma_1}{\epsilon_0}, \quad E_2 = \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 r_2^2} = \frac{\sigma_2}{\epsilon_0}$$

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{\sigma_1}{\sigma_2} = \frac{Q_1}{Q_2} \frac{r_2^2}{r_1^2} = \frac{r_1}{r_2}$$

# Siła działająca na przewodnik

$\vec{E}_{\text{teby}}$  - pole pochodzące od ładunków w tebie

$\vec{E}'$  - pole pochodzące od innych ładunków



$$\vec{E} = \vec{E}_{\text{teby}} + \vec{E}'$$

Pole pochodzące od teby:

$$\vec{E}_{\text{teby}} = \begin{cases} \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \hat{n}, & z > 0 \\ -\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \hat{n}, & z < 0 \end{cases}$$

Konsterny z zasady superpozycji:

- Pole elektryczne nad przewodzącą powierzchnią:

wynosi: 
$$\vec{E}_{\text{nad}} = \left(\frac{\sigma}{2\epsilon_0}\right) \hat{n} + \vec{E}'$$

- Pole elektryczne pod przewodzącą powierzchnią:

$$\vec{E}_{\text{pod}} = -\left(\frac{\sigma}{2\epsilon_0}\right) \hat{n} + \vec{E}'$$

stąd dostajemy, że

$$\vec{E}_{\text{sr.}} = \vec{E}' = \frac{1}{2} (\vec{E}_{\text{nad}} + \vec{E}_{\text{pod}}) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \hat{n}$$

średnie wartości pola wewnątrz na składową normalną

$$\rightarrow \begin{matrix} \parallel & \parallel \\ \frac{\sigma}{\epsilon_0} \hat{n} & 0 \end{matrix}$$

czyli siła działająca na tą część wynosi:

$$\vec{F} = q \vec{E}_{\text{sr.}} = (\sigma A) \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \hat{n} = \frac{\sigma^2 A}{2\epsilon_0} \hat{n}$$

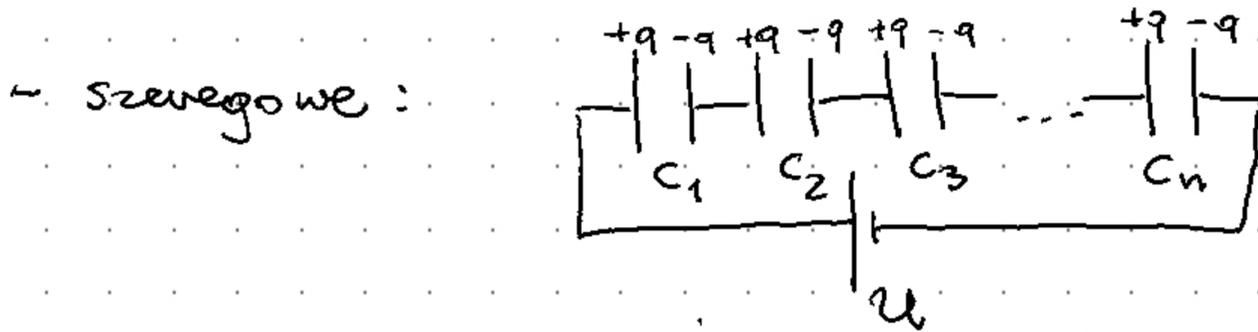
Cisnienie elektrostatyczne działające na tacie!

$$p = \frac{F}{A} = \frac{\sigma^2}{2\epsilon_0} = \frac{1}{2} \epsilon_0 \left( \frac{\sigma}{\epsilon_0} \right)^2 = \frac{1}{2} \epsilon_0 E_{\text{normalna}}^2$$

## Kondensatory i dielektryki

Pojemność kondensatora z definicji: wynosi:  $C = \frac{Q}{U}$

Łączenie kondensatorów:



Na każdym kondensatorze następuje spadek

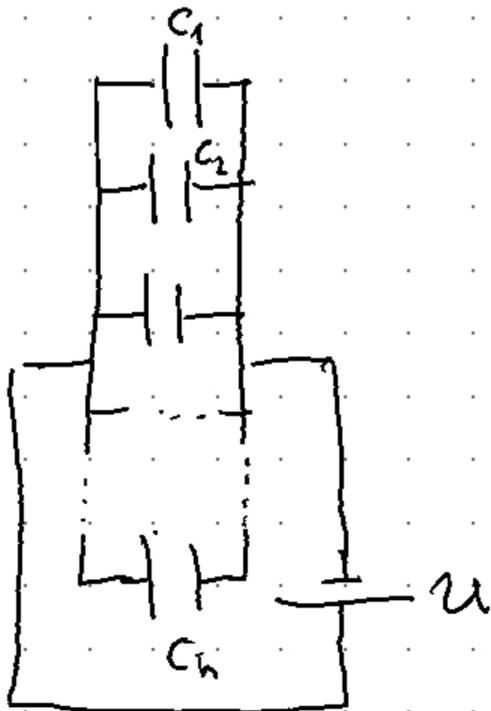
napięcia:  $U = U_1 + U_2 + \dots + U_n =$

$$= \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2} + \dots + \frac{Q}{C_n} = Q \sum_{j=1}^n \frac{1}{C_j}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{C^*} = \sum_{j=1}^n \frac{1}{C_j}$$

↑  
pojemność zastępcza

- równoległe:



Napięcie jest stałe

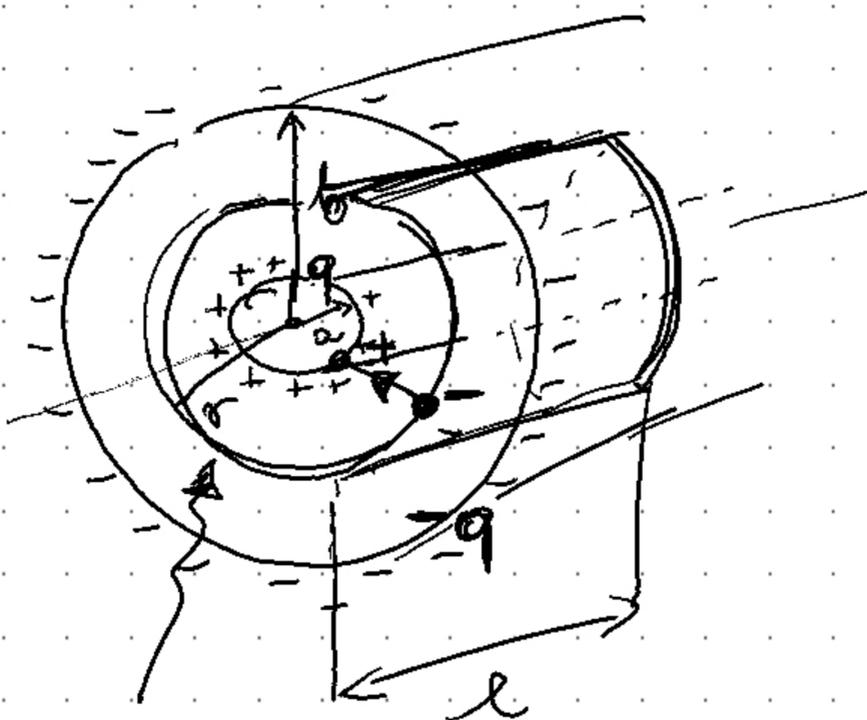
na wszystkich kondensatorach

$$Q = Q_1 + Q_2 + Q_3 + \dots + Q_n$$

$$Q = C_1 U + C_2 U + \dots + C_n U$$

$$\Rightarrow C^* = \frac{Q}{U} = \sum_{j=1}^n C_j$$

# Przykład: Kondensator cylindryczny



powierzchnia Gaussa

Konstanty  $\epsilon$  i prawa

Gausa:

i)  $r > b$ ,  $Q_{\text{wek}} = 0$

$$\Rightarrow E = 0$$

ii)  $r \in [a, b]$ ,  $Q_{\text{wek}} = q$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = E 2\pi r l = \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$\Rightarrow E = \frac{q}{2\pi \epsilon_0 l r}$$

iii)  $r < a$ ,  $Q_{\text{wek}} = 0$

$$\Rightarrow E = 0$$

Szukamy napięcia: ( $\varphi_+ > \varphi_-$ )

$$U = \varphi_+ - \varphi_- = \int_+^- \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_b^a \frac{q}{2\pi \epsilon_0 l r} dr =$$

$$= \frac{q}{2\pi \epsilon_0 l} \int_b^a \frac{dr}{r} = \frac{q}{2\pi \epsilon_0 l} \ln\left(\frac{b}{a}\right),$$

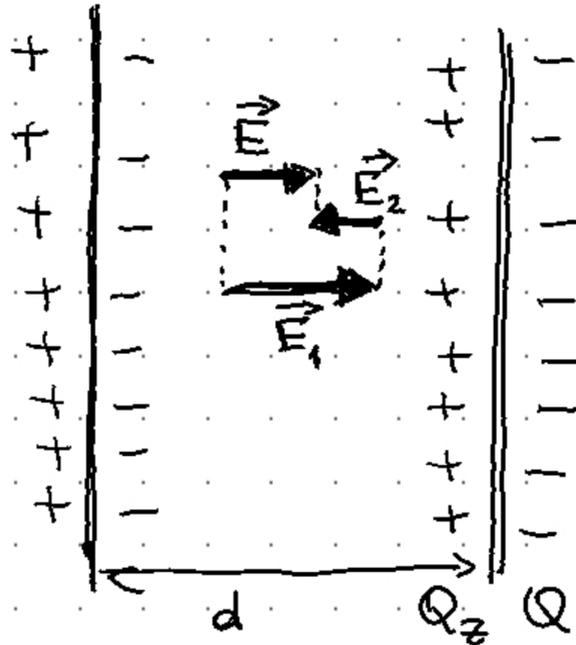
a stąd mamy  $C = \frac{q}{U} = 2\pi \epsilon_0 \frac{l}{\ln(b/a)}$

- Energia pola elektrycznego w kondensatorze

$$dW = U dq = \frac{q'}{C} dq' \Rightarrow W = \int dW = \int_0^q \frac{q'}{C} dq' = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C}$$

$$\Rightarrow W = \frac{1}{2} C U^2 - \text{praca związana z ładowaniem kondensatora}$$

# Dielektryk w kondensatorze



$\vec{E}_1$  - pole pochodzące od obładowek  
 $\vec{E}_2$  - pole od ładunków związanych  $Q_z$

$$E_1 = \frac{Q}{\epsilon_0 S}, \quad E_2 = \frac{Q_z}{\epsilon_0 S}$$

$$E = E_1 - E_2 = \frac{1}{\epsilon_0} \left( \frac{Q}{S} - \frac{Q_z}{S} \right) = \frac{U}{d}$$

$$Q = \epsilon_r C_0 U$$

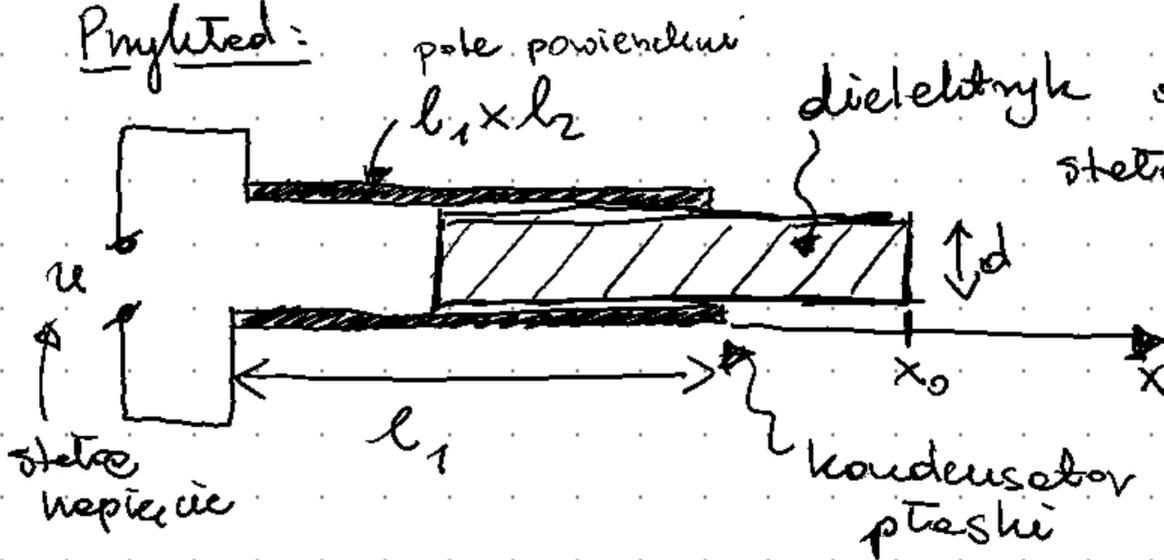
↑ pojemność kondensatora próżniowego

$$Q_z = Q \left( 1 - \frac{1}{\epsilon_r} \right)$$

względnie przenikalność dielektryczna

$$Q - Q_z = \frac{Q}{\epsilon_r} - \text{ładunek swobodny}$$

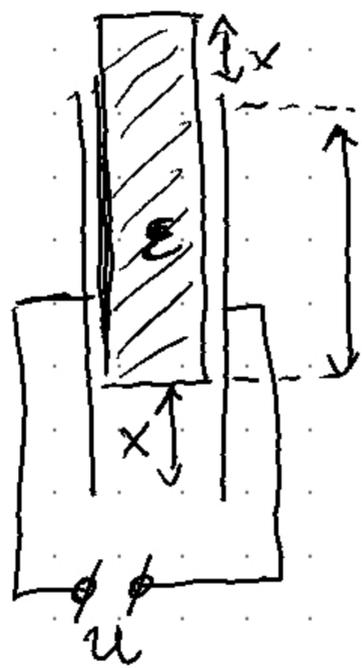
Przykład:



dielektryk o masie  $m$  i stałej dielektrycznej  $\epsilon$   
 $d \ll l_1, d \ll l_2$

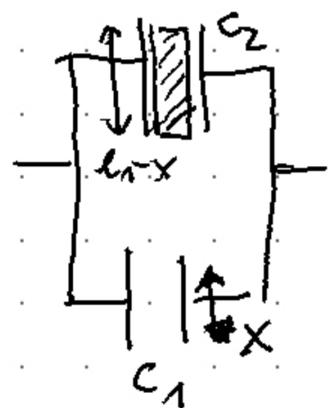
Wysunięta płyta puszono swobodnie. Zaniedbując tarcie znaleźć zależność przemieszczenia i prędkości od czasu.

Gdy płyta jest wysunięta z kondensatora na odległość  $x \leq l_1$ , pojemność kondensatora wynosi



$l_1 - x$

$\Rightarrow$



$$C_x = C_1 + C_2 =$$

$$= \epsilon_0 l_2 [x + \epsilon(l_1 - x)] / d$$

Pojemność kondensatora:

$$C(x) = \frac{\epsilon_0 l_2}{d} [x + \epsilon(l_1 - x)]$$

Energia kondensatora:  $W(x) = \frac{1}{2} C(x) U^2$

ładunek na okładkach:  $Q(x) = C(x) U$

Zasada zachowania energii:

$$\Delta E_k + W(x + \Delta x) = W(x) + W_{zr}$$

$\Delta E_k$   
zmiana energii kinetycznej kondensatora

$W_{zr}$   
praca źródła

$$W_{zr} = [Q(x + \Delta x) - Q(x)] U = \Delta C U^2$$

stad:  $\Delta E_k = \Delta C \frac{U^2}{2} = - \frac{\epsilon_0 l_2 (\epsilon - 1) U^2}{2d} \Delta x$

$$\Delta E_k = F_x(x) \Delta x \Rightarrow F = \frac{\epsilon_0 l_2 (\epsilon - 1) U^2}{2d}$$

$F$   
siła działająca wzdłuż  $x$  na dielektryk

- siła z którą dielektryk jest wciągany do kondensatora

$a = F/m$ , czyli

$$x(t) = x_0 - \frac{at^2}{2}, \quad v_x(t) = -at$$

Dielektryk wykonuje drganie wokół  $x=0$ ,

gdzie  $v_{max} = \sqrt{2ax_0}$ , a okres drgań  $T = 4\sqrt{2x_0/a}$

